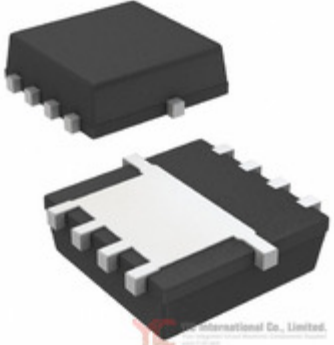

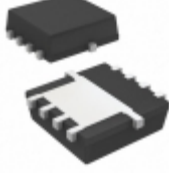







	<h2 style="color: #D9534F;">SISA14DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISA14DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8
	Datenblätter:  SISA14DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 23483 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISA14DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23483 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.1 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.57W (Ta), 26.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1450pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SISA14DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA14DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA14DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISA14DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISA12ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25A 1212-8</p>	 <p>SiSA18ADN Vishay SISA18ADN Vishay</p>	 <p>SISA16DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V D-S PPAK 1212-8</p>	 <p>SISA18ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 38.3A 1212-8</p>
 <p>SISA12ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A 1212-8</p>	 <p>SISA12DN-T1-GE3 VISHAY SISA12DN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SiSA14DN Vishay SISA14DN Vishay</p>	 <p>SISA14DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8</p>

SISA14DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3
SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3
SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3
SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3	SISA14DN-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited